



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

窄手性、半导体性单壁碳纳米管的宏量、可控生长方法

文献类型: 专利

作者 刘畅、赵石永、侯鹏翔、成会明

发表日期 2016-08-17

专利国别 中国

专利类型 发明

权利人 刘畅、赵石永、侯鹏翔、成会明

中文摘要 窄手性、半导体性单壁碳纳米管的宏量、可控生长方法

公开日期 2016-08-17

申请日期 2014-09-01

语种 中文

专利申请号 201410441540.3

源URL [<http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/78812>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 刘畅、赵石永、侯鹏翔、成会明. 窄手性、半导体性单壁碳纳米管的宏量、可控生长方法. 2016-08-17.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
34	0	0

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。